

# 进口光刻胶 代理 光刻胶 赛米莱德

产品名称	进口光刻胶 代理 光刻胶 赛米莱德
公司名称	北京赛米莱德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208
联系电话	15201255285 15201255285

## 产品详情

9, 去胶:湿法去胶, 用溶剂、用NONG硫酸。负胶,  $98\%H_2SO_4+H_2O_2+胶=CO+CO_2+H_2O$ , 正胶: BIN 酮, 进口光刻胶日本, 干法去胶 (ash) 氧气加热去胶  $O_2+胶=CO+CO_2+H_2O$ , 等离子去胶 Oxygen plasma ashing, 高频电场  $O_2$ ---电离  $O^- + O^+$ ,  $O^+$  活性基与胶反应  $CO_2, CO, H_2O$ , 光刻检验

### 光刻胶市场

据统计资料显示, 2017年中国光刻胶行业产量达到7.56万吨, 较2016年增加0.29万吨, 其中, 中国本土光刻胶产量为4.41万吨, 与7.99万吨的需求量差异较大, 说明我国供给能力还需提升。

国内企业的光刻胶产品目前还主要用于PCB领域, 光刻胶, 代表企业有晶瑞股份、科华微电子。

在半导体应用领域, 随着汽车电子、物联网等发展, 进口光刻胶 价格, 会在一定程度上增加对G线、I线的需求, 利好G线、I线等生产企业。预计G线正胶今后将占据50%以上市场份额, I线正胶将占据40%左右的市场份额, DUV等其他光刻胶约占10%市场份额, 给予北京科华、苏州瑞红等国内公司及美国futurex光刻胶较大市场机会。

### 三、光刻胶涂覆 ( Photoresist Coating )

光刻胶涂覆通常的步骤是在涂光刻胶之前, 进口光刻胶 代理, 先在900-1100度湿氧化。氧化层可以作为湿法刻蚀或B注入的膜版。作为光刻工艺自身的首先过程, 一薄层的对紫外光敏感的有机高分子化合物, 即通常所说的光刻胶, 要涂在样品表面( $SiO_2$ )。首先光刻胶被从容器中取出滴布到置于涂胶机中的样品表面, (由真空负压将样品固定在样品台上), 样品然后高速旋转, 转速由胶粘度和希望胶厚度确定。在这样的高速下, 胶在离心力的作用下向边缘流动。

涂胶工序是图形转换工艺中最初的也是重要的步骤。涂胶的质量直接影响到所加工器件的缺陷密度。为了保证线宽的重复性和接下去的显影时间, 同一个样品的胶厚均匀性和不同样品间的胶厚一致性不应超

过  $\pm 5\text{nm}$ (对于 $1.5\mu\text{m}$ 胶厚为  $\pm 0.3\%$ )。

光刻胶的目标厚度的确定主要考虑胶自身的化学特性以及所要图形中线条的及间隙的微细程度。太厚胶会导致边缘覆盖或连通、小丘或田巨状胶貌、使成品率下降。在MEMS中、胶厚(烤后)在 $0.5\text{-}2\mu\text{m}$ 之间，而对于特殊微结构制造，胶厚度有时希望 $1\mu\text{m}$ 量级。在后者，旋转涂胶将被铸胶或等离子体胶聚合等方法取代。常规光刻胶涂布工序的优化需要考虑滴胶速度、滴胶量、转速、环境温度和湿度等，这些因素的稳定性很重要。

在工艺发展的早期，负胶一直在光刻工艺中占主导地位，随着VLSI IC和 $2\sim 5$ 微米图形尺寸的出现，负胶已不能满足要求。随后出现了正胶，但正胶的缺点是粘结能力差。

用正胶需要改变掩膜版的极性，这并不是简单的图形翻转。因为用掩膜版和两种不同光刻胶结合，在晶圆表面光刻得到的尺寸是不一样的，由于光在图形周围的衍射效应，使得用负胶和亮场掩膜版组合在光刻胶层上得到的图形尺寸要比掩膜版上的图形尺寸小。用正胶和暗场掩膜版组合会使光刻胶层上的图形尺寸变大。

进口光刻胶 代理-光刻胶-赛米莱德由北京赛米莱德贸易有限公司提供。北京赛米莱德贸易有限公司 ([www.semild.com](http://www.semild.com)) 在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，赛米莱德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：况经理。